



1. 芯片特征

- (1) SIPOS和GPP双层钝化保护工艺
- (2) 单台面外沟槽工艺
- (3) $V_{RRM} \geq 1600V$
- (4) 正面金属层:AL或Ti-Ni-Ag
- (5) 背面金属层:Ti-Ni-Ag

2. 芯片尺寸

- (1) 5.8mm×5.8mm

3. 主要用途

- (1) 整流电源
- (2) 其他整流应用



4. 产品极限参数

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 数值 |
|-----------|-------------|------------|--|-----------|
| 反向重复峰值电压 | V_{RRM} | V | $T_j=25^\circ C, I_{RRM}=5\mu A$ | 1600 |
| 反向不重复峰值电压 | V_{RSM} | V | $T_j=25^\circ C, I_{RRM}=5\mu A$ | 1700 |
| 正向平均电流 | $I_{F(AV)}$ | A | $T_s=80^\circ C, T_j=150^\circ C$ | 35 |
| 正向浪涌电流 | I_{FSM} | A | $tp=10ms, \sin 180^\circ, T_j=150^\circ C$ | 420 |
| 电流时间积分 | I^2t | A^2s | $T_j = 150^\circ C, tp=10ms, \sin 180^\circ$ | 880 |
| 结温范围 | T_j | $^\circ C$ | | -40 ~ 150 |

5. 其他检查标准

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 标准数值 | | | 检验数量 | |
|-------|-----------|----|---------------------------------|-------------------|-----|-----|------|--------|
| | | | | 最小值 | 平均值 | 最大值 | | |
| 反向漏电流 | I_R | mA | $V_R=1600V$ | $T_j=25^\circ C$ | - | - | 0.1 | 抽检(5%) |
| | | | | $T_j=145^\circ C$ | - | - | 2 | |
| 正向压降 | V_F | V | $I_F=5A, T_j=25^\circ C$, 芯片测试 | - | 0.9 | 1 | 全数 | |
| 外观检验 | (1) 玻璃裂纹 | | - | - | - | 全数 | | |
| | (2) 金属层侵蚀 | | - | - | - | | | |

6. 芯片结构

| 名称 | 符号 | 单位 | 尺寸 | 说明 |
|---------------|----|---------|----------------|----|
| 芯片尺寸 | U | mm | 5.8 ± 0.05 | |
| 沟槽尺寸 | W | mm | 4.9 ± 0.1 | |
| 金属尺寸 | X | mm | 4.8 ± 0.1 | |
| 芯片厚度 | Y | μm | 300 ± 10 | |
| 沟槽深度 | Z | μm | 140 ± 20 | |
| AL金属层厚度 | | μm | 7 ± 1 | |
| Ti-Ni-Ag金属层厚度 | | μm | $1.5 \sim 2.0$ | |

